

Silizium-npn-Leistungsschalttransistor für allgemeine Anwendung

Bauform 5 TO3

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 2,0 \text{ K/W}$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

U_{CBO} ($I_E = 0$)	800 V
U_{CEO} ($I_B = 0$)	400 V
I_C	4,0 A
I_{CM}	6,0 A
P_{tot} ($\vartheta_c \leq 50^\circ\text{C}$)	50 W
ϑ_j	-40 ... +150 °C
ϑ_a	-40 ... +100 °C

Elektrische Kennwerte bei $\vartheta_j 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$

I_{CEX}	($U_{CE} = 800 \text{ V}, U_{BE} = -2 \text{ V}$)	$\leq 1,0 \text{ mA}$
U_{CEsat}	($I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}$)	$\leq 1,5 \text{ V}$
U_{BEsat}	($I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}$)	$\leq 1,6 \text{ V}$
$U_{(BR)EBO}$	($I_E = 10 \text{ mA}$)	$\geq 6,0 \text{ V}$
t_f	($I_C = 2,5 \text{ A}, I_B = 0,5 \text{ A}, -I_B = 1,0 \text{ A}$)	$\leq 1,0 \mu\text{s}$